



中华人民共和国国家标准

GB/T 15450—1995

硅双栅场效应晶体管 空白详细规范

Blank detail specification for silicon dual-gate
field-effect transistors

1995-01-05 发布

1995-08-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
硅 双 栅 场 效 应 晶 体 管
空 白 详 细 规 范
GB/T 15450—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1995 年 7 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-11559

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

硅双栅场效应晶体管
空白详细规范

GB/T 15450—1995

Blank detail specification for silicon
dual-gate field-effect transistors

本空白详细规范规定了制订硅双栅场效应晶体管详细规范的基本原则,制订该范围内的所有详细规范应与本空白详细规范一致。

本空白详细规范是半导体器件空白详细规范系列中的一个,并应与下列规范一起使用:GB 4589.1《半导体器件分立器件和集成电路总规范》,GB 12560《半导体器件分立器件分规范》

要求资料:

本页及下页括号内所示的数字,对应于以下要求资料的项目,并列入规定的栏目中。

详细规范的识别:

- (1)批准发布本详细规范的组织:国家标准机构的名称
- (2)详细规范的 IECQ 号。
- (3)总规范号,分规范号和版本号。
- (4)详细规范号,发布日期及国家体系要求的任何更多的资料。

器件的识别:

- (5)器件类型的简单说明。
- (6)典型结构和应用的资料。

如果设计一种器件满足若干应用,则应在详细规范中指出。对于这些应用特性、极限值及检验要求均应满足。

对静电敏感器件,应写上警告说明。

- (7)外形图和(或)引用有关的外形文件。
- (8)质量评定类别。
- (9)能在器件类型之间比较的最重要的特性参考数据。